

1uA+超低功耗 PMU,集成 16V 耐压线性充电和 5V 升压转换器

描述

ETA9697 是一个超低功耗的双通道 PMU:集成了独立的 16V 耐压的线性充电器和 5V 同步升压变换器。该线性充电器内建全功能的恒流/恒压充电模组,充电功率管和非常少的外围。它同样含有涓流充电和可通过外部电阻设定的全速充电电流。当进入恒压充电,且充电电流小于预设值的 1/10,则充电完成。一个"stat"引脚用于指示充电状态。其低功耗的 5V 升压变换器可支持高达5V-0.4A 的输出能力,且可以通过对 ENBST 引脚置低电平,可实现彻底关闭输出。ETA9697 内置 1.4MHz 的开关频率,可以使用极少的 2.2uH 电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。

ETA9697 采用 ESOP8 封装。

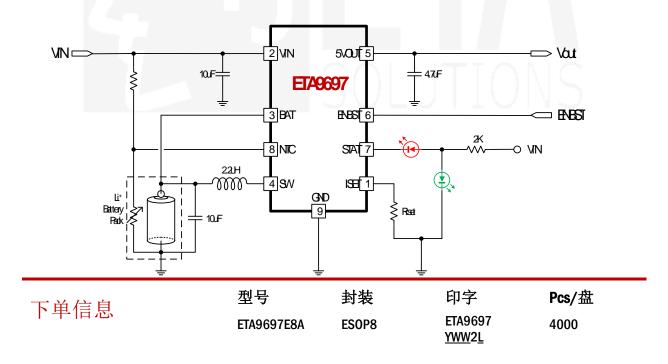
特征

- ◆ 超低工作电流,低至 1uA+
- ◆ 16V 输入耐压
- 4.2V 充电浮充电压
- ◆ 充电电流可设,最高可达 1.2A
- ◆ 多充保护,过热,短路,过流等
- ◆ 5V/0.4A 输出能力
- ◆ 高达 94% 升压变换效率
- ◆ 真关断™专利技术
- ◆ 可使能关闭输出,过热停机保护
- ◆ ESOP8 封装

应用

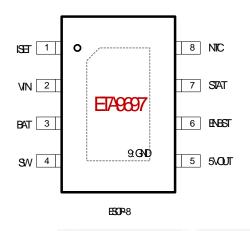
- ◆ TWS 蓝牙充电仓
- 小功率无线充电输入的设备
- ◆ NBIOT 产品

典型应用





引脚信息



最大极限值

(注: 使用时超出此极限参数会导致电路损毁或影响长期可靠性)

VIN, BAT 电压0.3V to 16V			
SW, ISET, NTC, STAT, ENBST, 5VOUT $$ $\mathbb{1}$ $\mathbb{1}$ $\mathbb{1}$ 0.3V to 6.5V			
SW 对地电流Internally limited			
工作温度范围40°C to 85°C			
存储温度范围55°C to 150°C			
封装热阻 θ _{JA} θ _{JC}			
ESOP80°C/W			
引脚温度 (焊接, 10ssec)260°C			
ESD HBM (人体模式)2KV			
ESD MM (机械模式)200V			

电特性参数

(V_{BAT}=3.8V, V_{IN}=5V, V_{OUT} = 5V, u 除非特别说明,环境温度 TA = 25℃)

参数	测试条件	MIN	TYP	MAX	单位
线性充电器					
输入最大耐压		16			V
输入过压保护电压	VIN 上升, 迟滞=0.3V	6.5	7	7.4	V
输入工作电压		4.25		6	V
	充电模式		300	2000	μA
输入工作电流	待机模式 (充电截止)		65	100	μA
	停机模式 (ISET 悬空, EN=0,		25	50	μΑ
	VIN <vbat, td="" vin<vulo)<="" 或=""><td></td><td>_</td><td></td><td></td></vbat,>		_		
充电浮充电压	Rset = 10K, IBAT = 40mA	4.16	4.2	4.24	V
	Rset = 10K, 恒流模式	90	100	110	mA
BAT 引脚电流	Rset = 2K, 恒流模式	432	480	528	mA
	Rset = 1K, 恒流模式	820	920	1020	mA
涓流充电电流	VBAT < VTRIKL, Rset = 2K	20	50	110	mA
涓流充电阈值电压	VBAT Rising	2.75	2.93	3.1	V
涓流充电迟滞电压		100	130	165	mV
VIN 欠压闭锁	VIN 从高到低	3.05	3.35	3.6	V
VIN 欠压闭锁迟滞电压		0.4	0.55	0.65	V
VIN-VBAT 欠压闭锁最小压差	VIN 从低到高	50	100	140	mV
	VIN 从高到低	5	30		mV
C/10 截止电流阈值		0.085	0.1	0.115	mA/mA
ISET 引脚电压	恒流模式,VBAT=4V		1		V
STAT 引脚下拉电流	V_STAT = 5V		0.1		μΑ



STAT 引脚低电平电压	参数	测试条件		TYP	MAX	单位
対点平衡时芯片结温	STAT 引脚低电平电压	I_STAT= 5mA		0.35	0.6	V
Power FET "ON" 导通阻抗 (VCC 和 BAT 直接) 1BAT = 0 至 1BAT 100 μs 软启动时间 IBAT = 0 至 1BAT 100 μs 自动再充电比较器检测时间 VBAT 从高到低 400 1000 2500 μs μs 过热比较器检测时间 IBAT 下降至 ICHG/10 400 1000 2500 μs μs ISET 引脚上拉电流 1 μA μA NTC 冷点阈值 停机 42 45 % VIN % VIN NTC 法点阈值 NTC 短路到 GND NTC 短路到 GND NTC 其闭阈值 NTC 短路到 GND NTC 短路到 GND NTC Input Leakage 0 1 μA 升压变换器 Veness=IN, Vbat=4V 1 2 μA Shutdown Supply Current at ENBST Veness=GND 0.5 μA BAT 并作电流 Iour=1mA 0.8 V BAT 工作电压 After Start-up 1.0 4.5 V SV 输出电压 1.0 4.5 V 开关频率 1.4 MHz NMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mΩ PMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mΩ PMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mΩ PMOS 开关电流限流 1 A A Enbarka Richard 1 A A Cor sw=0V 10 μA A	BAT 再充电阈值	VFLOAT - VRECHRG	90	120	150	mV
和 BAT 直接) 較启动时间	过热平衡时芯片结温			120		°C
軟启动时间 IBAT = 0 至 IBAT = 1000V/RSET 100 μs 自动再充电比较器检测时间 VBAT 从高到低 400 1000 2500 μs μs 过热比较器检测时间 IBAT 下降至 ICHG/10 400 1000 2500 μs μs ISET 引脚上拉电流 1 μA μA NTC 冷点阈值 停机 80 83 % VIN NTC 热点阈值 停机 42 45 % VIN NTC 浸闭阈值 NTC 短路到 GND NTC 短路到 GND NTC Input Leakage 0 1 μA サ上床交換器 BAT 静态工作电流 Venesr=IN, Vbat=4V 1 2 μA Shutdown Supply Current at ENBST Venesr=GND 0.5 μA VBAT 启动电压 Iour=1mA 0.8 V BAT 工作电压 After Start-up 1.0 4.5 V SV 输出电压 4.85 5 5.15 V 开关频率 1.4 MHz NMOS 开关阻抗 Isw=100mA 220 mQ PMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mQ SW 漏电流极限 Vour=5.2V, Ven=GND, Vsw=5.2V or Vsw=5.2V or Vsw=0V 10 μA NMOS 开关电流限流 0 N 1.3 ms 医路打嗝时间 ON 1.3 ms 医路打嗝时间 Ven=5V or OV -1 0 1 μA <	Power FET "ON" 导通阻抗 (VCC			0.5		ohm
=1000V/RSET	和 BAT 直接)					
自动再充电比较器检测时间 过热比较器检测时间 VBAT 从高到低 400 1000 2500 μs ISET 引脚上拉电流 1 μA NTC 冷点阈值 停机 80 83 % VIN NTC 热点阈值 停机 42 45 % VIN NTC 迟滞 2 % VIN NTC 短期值 NTC 短路到 GND 0 1 μA NTC jupit Leakage 0 1 μA H压变换器 0 1 μA H上变换器 0 1 μA HLTC 支换器 0 1 μA Shutdown Supply Current at ENBST Venest=GND 0.5 μA VBAT 启动电压 lour=1mA 0.8 V VBAT 上电压 After Start-up 1.0 4.5 V SV 输出电压 4.85 5 5.15 V 开关频率 1.4 MHz NMOS 开关阻抗 Isw=100mA 220 mQ PMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mQ SW 漏电流极限 0 Venest	软启动时间	IBAT = 0 至 IBAT		100		μs
対無比较器检测时间		=1000V/RSET				
ISET 引脚上拉电流	自动再充电比较器检测时间	VBAT 从高到低	400	1000	2500	μs
NTC	过热比较器检测时间	IBAT 下降至 ICHG/10	400	1000	2500	μs
NTC 热点阈值	ISET 引脚上拉电流			1		μΑ
NTC 短滯	NTC 冷点阈值	停机		80	83	% VIN
NTC 美闭阈值	NTC 热点阈值	停机	42	45		% VIN
NTC Input Leakage	NTC 迟滞			2		% VIN
升压变换器 BAT 静态工作电流 Venest = IN, Vbat=4V 1 2 μA Shutdown Supply Current at ENBST Venest = GND 0.5 μA VBAT 启动电压 lour=1mA 0.8 V BAT 工作电压 After Start-up 1.0 4.5 V 5V 输出电压 4.85 5 5.15 V 开关频率 1.4 MHz NMOS 开关阻抗 Isw=100mA 220 mΩ PMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mΩ SW 漏电流极限 Vour=5.2V, Ven=GND, Vsw=5.2V or Vsw=5.2V or Vsw=0V 10 μA NMOS 开关电流限流 1 A A 启动电流限流 1 A A 短路打嗝时间 ON 1.3 ms ENBST 输入电流 Ven=5V or OV -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 Vour=5V 1.2 V ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V	NTC 关闭阈值	NTC 短路到 GND				
BAT 静态工作电流 VENBST=IN, Vbat=4V 1 2 μA Shutdown Supply Current at ENBST VENBST = GND 0.5 μA VBAT 启动电压 Iour=1mA 0.8 V BAT 工作电压 After Start-up 1.0 4.5 V 5V 输出电压 4.85 5 5.15 V 开关频率 1.4 MHz NMOS 开关阻抗 Isw=100mA 220 mΩ SW 漏电流极限 Vour=5.2V, Ven=GND, Vsw=5.2V or Vsw=5.2V or Vsw=0V 10 μA NMOS 开关电流限流 1 A 启动电流限流 1 A 短路打嗝时间 ON 1.3 ms ENBST 输入电流 Ven=5V or OV -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 Vour=5V 1.2 V ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V	NTC Input Leakage			0	1	μΑ
Shutdown Supply Current at ENBST Venbst = GND 0.5 μA VBAT 启动电压 lour=1mA 0.8 V BAT 工作电压 After Start-up 1.0 4.5 V 5V 输出电压 4.85 5 5.15 V 开关频率 1.4 MHz NMOS 开关阻抗 Isw=100mA 220 mΩ PMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mΩ SW 漏电流极限 Vour=5.2V, Ven=GND, Vsw=5.2V or Vsw=5.2V or Vsw=5.2V or Vsw=0V 10 μA NMOS 开关电流限流 1 A A 启动电流限流 1 A A 短路打嗝时间 ON 1.3 ms ENBST 输入电流 Ven=5V or OV -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 Vour=5V 1.2 V ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V	升压变换器					
ENBST VBAT 启动电压 lour=1mA 0.8 V BAT 工作电压 After Start-up 1.0 4.5 V 5V 输出电压 4.85 5 5.15 V 开关频率 1.4 MHz NMOS 开关阻抗 Isw=100mA 220 mΩ PMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mΩ SW 漏电流极限 Vour=5.2V, Ven=GND, Vsw=5.2V or Vsw=5.2V or Vsw=0V 10 μA NMOS 开关电流限流 1 A 启动电流限流 1 A 短路打嗝时间 ON 1.3 ms ENBST 输入电流 Ven=5V or OV -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 Vour=5V 1.2 V ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V	BAT 静态工作电流	V _{ENBST} =IN, Vbat=4V		1	2	μΑ
VBAT 启动电压 Iour=1mA 0.8 V BAT 工作电压 After Start-up 1.0 4.5 V 5V 输出电压 4.85 5 5.15 V 开关频率 1.4 MHz NMOS 开关阻抗 Isw=100mA 220 mΩ PMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mΩ SW 漏电流极限 Vour=5.2V, Ven=GND, Vsw=5.2V or Vsw=5.2V or Vsw=0V 10 μA NMOS 开关电流限流 1 A 启动电流限流 1 A 短路打嗝时间 ON 1.3 ms ENBST 输入电流 Ven=5V or OV -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 Vour=5V 1.2 V ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V	Shutdown Supply Current at	V _{ENBST} =GND		0.5		μΑ
BAT 工作电压 After Start-up 1.0 4.5 V 5V 输出电压 4.85 5 5.15 V 开关频率 1.4 MHz NMOS 开关阻抗 Isw=100mA 220 mΩ PMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mΩ SW 漏电流极限 Vour=5.2V, Ven=GND, Vsw=5.2V or Vsw=5.2V or Vsw=0V 10 μA NMOS 开关电流限流 1 A 启动电流限流 1 A 短路打嗝时间 ON 1.3 ms ENBST 输入电流 Ven=5V or OV -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 Vour=5V 1.2 V ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V	ENBST					
5V 输出电压 4.85 5 5.15 V 开关频率 1.4 MHz NMOS 开关阻抗 Isw=100mA 220 mΩ PMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mΩ SW 漏电流极限 Vour=5.2V, Ven=GND, Vsw=5.2V or Vsw=5.2V or Vsw=0V 10 μA NMOS 开关电流限流 1 A 启动电流限流 1 A 短路打嗝时间 ON 1.3 ms ENBST 输入电流 Ven=5V or OV -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 Vour=5V 1.2 V ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V		I _{OUT} =1mA		0.8		V
开关频率 1.4 MHz NMOS 开关阻抗 Isw=100mA 220 mΩ PMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mΩ SW 漏电流极限 Vour=5.2V, Ven=GND, Vsw=5.2V or Vsw=5.2V or Vsw=0V 10 μA NMOS 开关电流限流 1 A 启动电流限流 1 A 短路打嗝时间 ON 1.3 ms ENBST 输入电流 Ven=5V or 0V -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 Vour=5V 1.2 V ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V	BAT 工作电压	After Start-up	1.0		4.5	V
NMOS 开关阻抗 Isw=100mA 220 mΩ PMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mΩ SW 漏电流极限 Vour=5.2V, Ven=GND, Vsw=5.2V or Vsw=0V 10 μA NMOS 开关电流限流 1 A 启动电流限流 1 A 短路打嗝时间 ON 1.3 ms ENBST 输入电流 Ven=5V or OV -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 Vour=5V 1.2 V ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V	5V 输出电压		4.85	5	5.15	V
PMOS 开关阻抗 Isw=100mA 160 mΩ SW 漏电流极限 Vour=5.2V, VEN=GND, VSW=5.2V or VSW=0V 10 μA NMOS 开关电流限流 1 A 启动电流限流 1 A 短路打嗝时间 ON 1.3 ms ENBST 输入电流 VEN=5V or OV -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 Vour=5V 1.2 V ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V	开关频率			1.4	NIO	MHz
SW 漏电流极限 Vour=5.2V, Ven=GND, Vsw=5.2V or Vsw=5.2V 10 μA NMOS 开关电流限流 1 A 启动电流限流 1 A 短路打嗝时间 ON 1.3 ms ENBST 输入电流 Ven=5V or OV -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 Vour=5V 1.2 V ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V	NMOS 开关阻抗	Isw=100mA		220		mΩ
SW 漏电流极限 or Vsw= 0V 10 μA NMOS 开关电流限流 1 A 启动电流限流 1 A 短路打嗝时间 ON 1.3 ms ENBST 输入电流 V _{EN} =5V or 0V -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 Vour=5V 1.2 V ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V	PMOS 开关阻抗	I _{SW} =100mA	\cup \cup	160	LYU	mΩ
启动电流限流 1 A 短路打嗝时间 ON 1.3 ms OFF 33 ms ENBST 输入电流 V _{EN} =5V or OV -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 V _{OUT} =5V 1.2 V ENBST 低电平电压 V _{OUT} =5V 0.4 V	SW 漏电流极限	, ,			10	μΑ
短路打嗝时间 ON 1.3 ms OFF 33 ms ENBST 输入电流 V _{EN} =5V or 0V -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 V _{OUT} =5V 1.2 V ENBST 低电平电压 V _{OUT} =5V 0.4 V	NMOS 开关电流限流			1		Α
短路打嗝时间 OFF 33 ms ENBST 输入电流 V _{EN} =5V or 0V -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 V _{OUT} =5V 1.2 V ENBST 低电平电压 V _{OUT} =5V 0.4 V	启动电流限流			1		Α
OFF 33 ms ENBST 输入电流 V _{EN} =5V or 0V -1 0 1 μA ENBST 高电平电压 V _{OUT} =5V 1.2 V ENBST 低电平电压 V _{OUT} =5V 0.4 V		ON		1.3		ms
ENBST 高电平电压 Vour=5V 1.2 V ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V	超路打嗝的 间	OFF		33		ms
ENBST 低电平电压 Vour=5V 0.4 V	ENBST 输入电流	V _{EN} =5V or 0V	-1	0	1	μA
	ENBST 高电平电压	V _{OUT} =5V	1.2			V
过热停机 上升, 迟滞=25°C 160 °C	ENBST 低电平电压	V _{OUT} =5V			0.4	V
	过热停机	上升,迟滞=25°C		160		°C

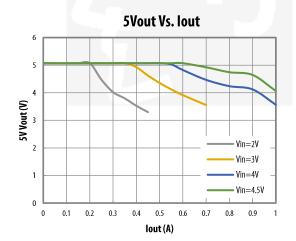


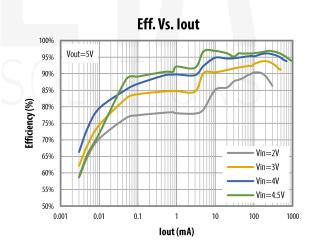
引脚描述

引脚#	名称	描述		
1	ISET	预设电流引脚,也可用于检测充电电流和停机控制。在全速恒流输出时,该引脚		
		为 1V。充电电流可使用 1%电阻器预设,充电电流遵循以下公式:		
		$I_{BAT} = \frac{1}{R_{set}} \times 1000 - (\frac{1}{3.6} \times \frac{1}{R_{set}} \times 1000)^2$		
		通过将 ISET 电阻接驳或断开,可用于充电和停机模式切换。		
2	VIN	输入供电,放置一个 10μF 退藕陶瓷电容器		
3	BAT	连接至电池正极,放置一个 10uF 退藕陶瓷电容器		
4	SW	连接电感。连接电感 SW 和和输出。		
5	5VOUT	输出引脚。放置一个 4.7µF 或更大的陶瓷电容器尽可能靠近此引脚。		
6	ENBST	升压使能,拉高工作,拉低为停机。		
7	STAT	充电指示开漏输出,该引脚在充电时输出低电平,当充电完成,则为高阻。		
8	NTC	NTC 电池温度检测引脚,确保电池温度在有效范围。		
9	GND	大地		

典型曲线

(除非特别说明,以环境温度 TA = 25° C)







应用信息

ETA9697是一个超低功耗的功率双通道PMU:一个16V耐压的锂电池线性充电器,以及一个具备真关断的5V同步升压变换器。

正常充电循环

ETA9697的Vin电压一旦上升至UVL0之上,就会开始到一个新的充电循环。一个1%精密电阻需要连接到ISET和地之间。当BAT上的电压低于2.9V,充电器会进入涓流充电模式。在这个模式下,充电电流会减少到1/10预设充电电流;当电池电压上升至安全充电水平时,会进入全速充电。

当电池电压大于2.9V时,充电器进入恒流充电模式,充电电流会上升至全速预设电流。当达到充电浮充电压(4.2V), ETA9697会进入恒压充电,充电电流开始下降,直至到1/10预设电流,则停止充电。

可编程充电电流

充电电流的设定可以通过在ISET对地接驳一个外部高精度电阻器。电池端充电电流是ISET引脚的1000倍。因此,电池端充电电流可以通过监测ISET引脚的电压来判定,其遵循符合以下公式:

$$I_{BAT} = \frac{1}{R_{sot}} \times 1000 - (\frac{1}{3.6} \times \frac{1}{R_{sot}} \times 1000)^2$$

充电截止

ETA9697 在充电进程中,会持续监测ISET引脚。当充电电流下降至预设电流的1/10,即ISET引脚电压下降至100mV,则会停止充电,从而进入待机模式,这时候供电电流下降至200μA。 (注: 在涓流模式下,C/10并不起作用)。

ETA9697 在待机模式下,会持续监测BAT引脚电压。当该电压下降至自动再充电阈值,会进入新的充电循环。设计者同样可以人为的复位充电循环,则通过将ISET引脚断开和重新连接。

充电状态指示器

一共有2种不同的充电状态指示:充电中和充电完成。STAT引脚在充电时,会被拉低;当充电完成,会被置高阻态。

过温度功率折返

内置的过温度环路能够有效的减少充电电流,从而让芯片的结温低于 100°C,避免芯片的温度持续增加。

欠压闭锁(UVLO)

内置的欠压闭锁电路会持续监控输入电压,确保充电器在VIN处于UVLO之前,保持在停机状态。UVLO电路内置了500mV的迟滞。内部保护电路具备电池防反接功能,当输入到到电池端的压降只有30mV时,UVLO电路会让芯片处于停机模式。如果UVLO比较器被保持,则不会再进入充电模式,除非Vin电



压比BAT电压高至少100mV。

自动再充电

当充电完成, ETA9697 会持续的监测BAT电压, 当电压低于4.08V时, 会重新开始新的充电周期, 从 而确保电池处于满电水平。在再充电周期, ISET引脚会输出一个强下拉状态。

电池温度监控器

ETA9697 会持续的监控 NTC 引脚的电压,来判定实际温度。一个负温度系数的电阻器和一个外部分压电阻来设定过热、过冷点的阈值。ETA9697 比较内部 80%VIN 和 45%VIN 阈值来决定充电是否被允许。温度检测电路的优先级会比 VIN 过压、欠压等状况判定要来得更高,当外部电压分压超过 80%VIN或 45%VIN,就会认为是过温度情形。如果 NTC 连接到 GND 会禁用温度检测功能。

空载输出时,超低的工作电流

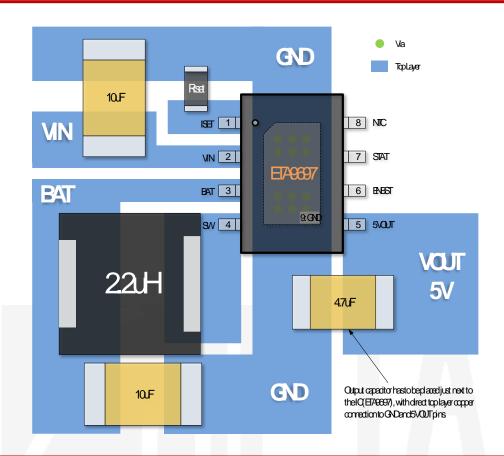
传统地,一个定频的 PWM DC/DC 转换器会在轻载时依然高速工作。而 ETA9697 采用了专利的控制环路,来提升空载时的效率,降低轻载时的工作电流。

输出 (5VOUT 引脚) 短路保护

不同于绝大部分的升压变换器,ETA9697允许输出端卢。在短路情形下,当超过电流限制,芯片会先关闭NMOS。当OUT下降至IN,芯片会进入一个带电流限制的线性充电周期。不仅如此,过热停机电路会在超过160°C时关闭升压工作。

PCB 布线建议





封装尺寸

封装: ESOP8

